

10月8日(火)

	A室(3F MOホール)	B室(2F 会議室2)	C室(2F 会議室3)
9:00	登録受付(1F エントランスホール)		
9:45	【1A1】パッケージ技術 座長：天明 浩之(日立製作所) 1. 金属接合を用いたCOF実装における温度サイクル性の検討 高藤 淳、斎藤秀隆、間部明(セイコーエプソン) 2. 20μmピッチ微細パワパ超音波接合技術 谷田一真、梅本光雄、富田至洋、安藤達也、森藤志洋、高橋健司(超先端電子技術開発機構) 3. 表面活性化による低温フリップチップ接合 富田 誠、伊藤寿浩、須賀健知(東京大学) 4. 100GHz対応ローコストMMICパッケージ 飯島真也、石月義克、林 信幸、水越正孝、増田 哲、志村利宏(富士通研究所)	【1B1】回路基板 座長：松岡 政夫(立命館大学) 1. 銅ナノ粒子分散がリミド膜の作製および微細線形成への応用 前田武昭、岩松茂、大塚順(豊隆工業) 池田慎吾、赤松謙右、縄舟秀美(甲南大学) 2. 中性無電解銅めっきのピアフィリングに及ぼす添加剤の影響およびめっき浴の電解再生 樋口晋吾、赤松謙右、縄舟秀美(甲南大学)、中尾成一郎、小幡恵吾(大和化成研究所) 3. 銅微細線の形成を目的とした添加剤の予備吸着を利用する銅電析プロセス 橋本守人、赤松謙右、縄舟秀美(甲南大学)、内田 衛(石原薬品) 4. ULSIバリア層およびキャップ層の形成を目的とした無電解Co系合金めっきプロセスの開発 松田賢茂、赤松謙右、縄舟秀美(甲南大学)	【1C1】鉛フリーはんだ 座長：竹本 正(大阪大学) 1. Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだ接合部における相成長による熱疲労き裂発生評価 山崎崇子、森 孝男(富山県立大学) 佐山麻彦(富山県工業技術センター)、長井喜昭、高柳 毅(コーセル) 2. Sn-3.5Ag はんだボールの接合強度と界面微細組織に及ぼすNiめっきの影響 長崎明、星加洋(関西大学) 藤原 裕(大阪市立工業研究所) 3. BGA用Sn-Ag系はんだとNP合金めっきとの界面微細構造観察 酒谷海弘、上西啓介、小林祐二郎(大阪大学)、小原泰浩(三洋電機)、佐佐野(日立製作所)、山本雅春(住友特殊金属) 4. Ni/AuめっきとSn-Ag系鉛フリーはんだの界面反応と接合部強度評価 平森裕幸、廣瀬雅夫、小林祐二郎(大阪大学) 伊藤剛司、吉川正雄、奥野雅彦、片桐 元(東レリサーチセンター)
11:05			
11:10	【1A2】パッケージ技術 座長：若林 信一(新光電気工業) 1. 薄型多層配線基板による高密度CSPの開発 馬場和宏、下戸直典、菊池 克、浦野 渡、大田広保、方慶一郎(日本電気) 2. 組立後工程での再配線技術による良品保証可能な極薄組込み型パッケージの開発 前田武彦、塚野 純(日本電気) 3. 高信頼度マルチチップパッケージの開発 福原真、菊池 広、野藤雅明、安藤英子、田中直敬、久保 貴(日立製作所) 4. 3層クラッド金属箔を用いた新規パッケージ用基板の提案 嶋田 修、鈴木和久、川崎良次(日立化成工業) 田中茂徳、藤原義行(日立金属)	【1B2】回路基板 座長：藤原 裕(大阪市立工業研究所) 1. ニッケルペース、セミアディティブ工法に求められるニッケルエッチング剤の開発 大串 亮(メック) 2. 低消費電力、低誘電率損失基板の為に開孔多孔質セラミックス材料の作製と評価 宮永倫正(住友電気工業) 3. コアレス半導体パッケージ基板の開発 榊 祐一、塚本健人、大熊隆正、飯塚一、秋本 聡(凸版印刷) 4. インプリント法による一括積層基板の検討 唐沢文明、中村 敏幸(鈴木)、小山昌一(新光電気工業)	【1C2】鉛フリーはんだ 座長：上西 啓介(大阪大学) 1. 鉛フリーはんだのフロープロセスにおけるはんだ微粒子の管理技術 猪野史実、末次憲一郎(松下電器産業)、日野俊治、田中正人(松下FAエンジニアリング)、高野宏明(松下テクノロジーリサーチ) 2. Snウイスキー防止効果を有するPbフリー-Sn-Cu合金めっき 柴田 勇、辻本雅宣、岡田哲明、村上 透(上村工業) 3. Sn-Si系高融鉛フリーはんだにおけるCuとの界面反応の基礎的検討 井出英一、柳川博人、今武史、廣瀬雅夫、小林祐二郎(大阪大学) 4. ステンレスのはんだ浸食特性とフロー槽への対応について 竹内 誠、早川 潔、穂坂 貴、佐藤 修、内海亮郎(日本ビクター)、吉川雅明、綿谷知久(日本金属工業)
12:30	昼 休 み		
13:20	【1A3】3次元実装 座長：小倉 洋(松下電器産業) 1. Chip on Chip 対応の超音波フリップチップ実装技術 安藤史彦、小倉 晃、夏秋昌典、小野和之(富士通) 2. COC(Chip On Chip)接合技術開発 栗田洋一郎、前田雅人、猪野雅司、野川 潤、塚崎雄、磯崎成也、木村光雄、藤原和彦、森下由昭(日本電気) 3. 3次元積層LSIにおける微細ピッチNCP圧接 梅本光雄、谷田一真、富田至洋、安藤達也、高橋健司(超先端電子技術開発機構) 4. 8個のLSIチップを搭載した3次元型マルチ・チップ・パッケージの開発 宇野 正、小野寺浩、宮田浩司、高島 晃(富士通) 5. 3次元実装モジュールの検討 佐藤浩三、三橋史典、松宮宏(新藤電子工業) 畑田賢造(アトムニクス研究所)	【1B3】MEMS 座長：齊藤 雅之(東芝) 1. バイオMEMSをシステム・オン・チップ化した電子回路デバイスの開発 磯田雄哉、上野州一、李 丞佑、櫻井和朗、新塚正治(北九州市立大学) 2. マイクロマシンプロープによる低接触力コンタクト 伊藤寿浩、河村晋吾、片岡憲一、須賀健知(東京大学) 3. LIGAで製作したコンタクトプロープの特性評価 依田 潤、平田嘉祐、羽野 剛、岡田一範、橋本章吾(住友電気工業) 4. Si マイクロマシニング技術を活用したウェハレベルパインシステム 河野裕也、金丸昌敏、清水浩也、青野宇紀、和田雄二(日立製作所) 5. 数値制御加工技術の新しい応用 河添 宏(日立化成工業)、曾根原剛志(日立製作所)	【1C3】樹脂接続・アンダーフィル 座長：菅沼 克昭(大阪大学) 1. C4接合用高機能アンダーフィルの開発 今泉匠、八木友久、伊藤 昭、堀越英二(富士通研究所)、吉村英明(富士通) 2. CSP用アンダーフィルに関する研究 小川将志、住川雅人、村山里奈、松原浩司(シャープ) 3. 各種チップサイズにおける高速アンダーフィル技術 辻野文一(ノードソンアシムテック) 4. 新しい樹脂成形機構による低温度化・高導電ペースト材料 本多俊之、岡本航司、伊藤雅史(藤倉化成) 5. 電源用IC基準電圧低変動パッケージング技術 高野新美、天野 彰、山崎 彰(富士電機総合研究所)、二階堂広基(住友ベークライト)、羽鳥行範(新光電気工業)
15:00			
15:10	招待講演 座長：貫井 孝(シャープ) 1. 「文化遺産のデジタルアーカイブ」 池内 克史 氏 (東京大学) 2. 「カーボンナノホーンを用いた携帯燃料電池」 久保 佳実 氏 (日本電気)		A 室： 3F MOホール B 室： 2F 会議室 2 C 室： 2F 会議室 3 D 室： 1F 会議室 1
16:40			
16:45	表章式		
16:55			

18:00	*懇親会 会場/千里阪急ホテル(北大阪急行、大阪モノレール「千里中央駅」から徒歩5分)
20:00	料金/5,000円(消費税込、MES参加費には含まれておりません)